



特許証

(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第6308583号

(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

薄膜トランジスタ、薄膜トランジスタの製造方法および半導体装置

特許権者
(PATENTEE)

茨城県つくば市千現一丁目2番地1

国立研究開発法人物質・材料研究機構

発明者
(INVENTOR)生田目 俊秀
相川 慎也

その他別紙記載

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2014-016635

出願日
(FILING DATE)

平成26年 1月31日(January 31, 2014)

登録日
(REGISTRATION DATE)

平成30年 3月23日(March 23, 2018)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成30年 3月23日(March 23, 2018)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

宗像直子



特許証

(CERTIFICATE OF PATENT)

(続葉 1)

特許第6308583号 (PATENT NUMBER)

特願2014-016635 (APPLICATION NUMBER)

発明者
(INVENTOR)

木津 きたき お
清水 希彦
三苫 伸一
塚越 仁

[以下余白]